06.2

Динамическая бистабильность в двухслойных магнитосвязанных пленках

© Д.И. Семенцов, А.М. Шутый

Ульяновский государственный университет

E-mail: sdi@sdi.ulsu.ru

Поступило в Редакцию 15 мая 2001 г.

Исследовано динамическое поведение магнитных моментов в двухслойной магнитосвязанной системе в области ферромагнитного резонанса с большими амплитудами угла прецессии. Обнаружены характерные для нелинейных явлений смещение частоты резонанса при увеличении СВЧ-поля, а также области динамической бистабильности по частоте и по подмагничивающему полю.

- 1. При взаимодействии высокочастотного излучения большой мощности с магнитоупорядоченными кристаллами в условиях ферромагнитного резонанса (ФМР) наблюдается целый ряд эффектов, обусловленных резким увеличением амплитуды колебаний намагниченности [1–5]. К таким эффектам можно отнести бистабильность и связанную с ней гистерезисную зависимость поглощаемой образцом мощности от подмагничивающего поля [6–9]. Наряду с этим в последнее время повышенное внимание уделяется исследованию резонансных свойств мультислойных систем, состоящих из чередующихся слоев ферромагнитного и немагнитного металлов, что связано с различными типами упорядочения намагниченности в слоях и соответственно многообразием их динамического поведения [10,11]. В настоящей работе исследуются особенности нелинейного ФМР в магнитосвязанной системе, состоящей из двух слоев ферромагнитного металла, разделенных немагнитной прослойкой, обеспечивающей коллинеарность магнитных моментов. Выявлены характерные для нелинейных явлений смещения резонансных частот слоев при увеличении амплитуды СВЧ-поля, а также области бистабильности в зависимости амплитуды колебаний магнитных моментов от частоты высокочастотного и величины подмагничивающего полей.
- 2. Будем считать, что система с двумя магнитосвязанными слоями намагничена в своей плоскости xy. Каждый из слоев толщиной d_i обладает намагниченностью \mathbf{M}_i , плоскостной одноосной анизотропией

2*

с константой K_i и осью легкого намагничивания, совпадающей с осью y. Внешнее подмагничивающее поле ${\bf H}$ также лежит в плоскости пленки, и его ориентация определяется углом α , отсчитываемым от оси y. Высокочастотное поле ${\bf h}(t)$ линейно поляризовано в плоскости пленки и перпендикулярно подмагничивающему полю. Решение динамического уравнения Ландау—Лифшица для рассматриваемой магнитосвязанной системы в линейном приближении приводит к следующему выражению для высокочастотной восприимчивости:

$$\chi = (d_1 \chi_1 + d_2 \chi_2)(d_2 + d_2)^{-1},\tag{1}$$

$$\chi_{i} = 4\pi\gamma^{2}M_{i}\frac{M_{i}\Delta_{3-i}\cos(\alpha-\varphi_{0i}) - 4\pi\gamma^{2}D_{i}M_{3-i}\cos(\alpha-\varphi_{03-i})}{\Delta_{1}\Delta_{2} - 16\pi^{2}\gamma^{4}D_{1}D_{2}},$$

где γ — гиромагнитное отношение, параметр $D_i = Ad_{12}M_1M_2/d_i$, $d_{12} = d_1d_2(d_1+d_2)^{-1}$ — приведенная толщина двух слоев; A — константа связи магнитных слоев, зависящая в общем случае от толщины и материала прослойки, ее структурных характеристик, φ_{0i} — равновесная ориентация намагниченности (при h=0). Входящие в (1) параметры

$$\Delta_i = \omega_{0i}^2 - \omega^2 - 4\pi\gamma^2 D_i + 4\pi i \lambda_i \omega, \tag{2}$$

где λ_i — параметры затухания, резонансные частоты изолированных слоев

$$\omega_{0i}^2 = 4\pi M_i \gamma^2 [H\cos(\alpha - \varphi_{0i}) + H_{ki}\cos 2\varphi_{0i}], \tag{3}$$

 $H_{ki} = 2K_i/M_i$ — поле магнитной анизотропии. Из (1) находятся резонансные частоты двухслойной системы. В пренебрежение затуханием ($\lambda_i = 0$) получаем:

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{\omega_{01}^2 + \omega_{02}^2}{2} - 2\pi\gamma^2 A M_1 M_2 \pm \frac{1}{4} \sqrt{\frac{(\omega_{01}^2 - \omega_{02}^2)^2}{4} + 2\pi\gamma^2 A M_1 M_2 \frac{d_1 - d_2}{d_1 + d_2} (\omega_{01}^2 - \omega_{02}^2) + (2\pi\gamma^2 A M_1 M_2)^2}.$$
(4)

Из (4) следует, что при отсутствии взаимодействия между слоями (A=0) резонансные частоты двухслойной пленки, т.е. нормальные частоты системы, совпадают с резонансными частотами отдельных слоев, тогда как при $A\neq 0$ имеет место сдвиг резонансных частот.

Если резонансные частоты свободных слоев совпадают ($\omega_{0i}=\omega_0$), то для резонансных частот связанных слоев получаем: $\omega_1^2=\omega_0^2$, $\omega_2^2=\omega_0^2-4\pi\gamma^2AM_1M_2$, что позволяет по их разности судить о величине константы связи между слоями. Видно, что в зависимости от знака константы связи A сдвиг резонансной частоты ω_2 может быть по отношению к частоте ω_0 как положительным, так и отрицательным.

3. Нелинейные эффекты становятся существенными при амплитудах высокочастотного поля, близких к пороговому значению $h_{thr} \cong (\Delta H_i^3/4\pi M_i)^{1/2}$, где ΔH_i — ширина линии линейного резонанса, при котором однородная прецессия становится неустойчи-Особенности прецессионного движения намагниченности с учетом нелинейных эффектов рассмотрим на основе численного решения динамического уравнения Ландау-Лифшица. Для упрощения анализа будем считать A < 0, что обеспечивает однонаправленность магнитных моментов в слоях в равновесном состоянии при H=0, а направление подмагничивающего поля выберем вдоль осей легкого намагничивания, т. е. примем $\alpha = 0$. При расчете будем использовать параметры, близкие к параметрам реальных пленок пермаллойного класса: $\lambda_1 = \lambda_2 = 5 \cdot 10^7 \, {
m s}^{-1}$, намагниченность и поле анизотропии первой пленки $4\pi M_1 = 8 \cdot 10^3$ Gs, $H_{k1} = 5$ Oe, второй — $4\pi M_2 = 1.1 \cdot 10^4$ Gs, $H_{k2} = 10 \,\mathrm{Oe}; \, \gamma = 1.76 \cdot 10^7 \,(\mathrm{Oe} \cdot \mathrm{s})^{-1}; \,$ толщины обеих пленок выберем равными, т. е. $d_1 = d_2 = 0.1 \, \mu$ т. Для указанных параметров нелинейные эффекты начинают проявляться при амплитудах СВЧ-поля $h \sim 1$ Oe.

На рис. 1 представлена частотная зависимость высокочастотной восприимчивости системы $\tilde{\chi}(M_1\cos\tilde{\varphi}_1+M_2\cos\tilde{\varphi}_2)/h$, где $\tilde{\varphi}_i$ — амплитуды углов стационарных колебаний магнитных моментов, полученные для различных амплитуд поля $h=0.1,\ 0.3,\ 0.5,\ 0.7,\ 0.9$ Ое (кривые I-4) при подмагничивающем поле H=0 и значении константы связи $|A|=5\cdot 10^{-3}$. Пунктирная кривая соответствует линеаризованному решению, построенному на основе (8). Приведенные зависимости показывают, что относительно линеаризованного решения даже при достаточно малых СВЧ-полях имеет место смещение резонансных частот в сторону их уменьшения. С ростом СВЧ-поля нелинейные эффекты усиливаются: указанное смещение максимумов резонансных кривых становится значительным, и увеличивается асимметрия резонансных кривых, что в итоге приводит к возникновению интервала бистабильности. При равных высокочастотных полях данный интервал оказывается бо́льшим в случае меньшей энергии связи между магнитными моментами слоев.

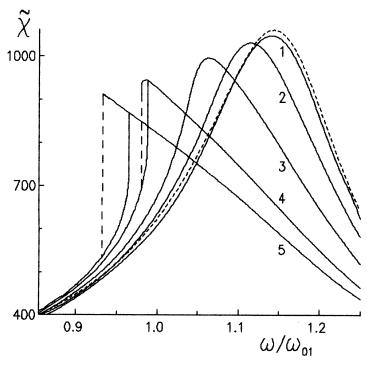


Рис. 1. Частотная зависимость высокочастотной восприимчивости системы, полученная для различных амплитуд СВЧ-поля при H=0 и $|A|=5\cdot 10^{-3}$; пунктирная кривая соответствует линеаризованному решению.

Рост СВЧ-поля приводит также к уменьшению резонансных значений магнитной восприимчивости.

Для реализации в режиме бистабильности состояния с большей амплитудой колебаний магнитных моментов пленок необходимо, чтобы начальное направление векторов \mathbf{M}_i было близко к направлению СВЧ-поля, т. е. $\varphi_0 \approx \pm \pi/2$. Этого можно добиться за счет дополнительного подмагничивающего поля, направленного по оси x, и выключаемого при включении высокочастотного поля h (при t=0). На реализацию того или иного динамического состояния в режиме бистабильности оказывает влияние также начальная фаза СВЧ-поля.

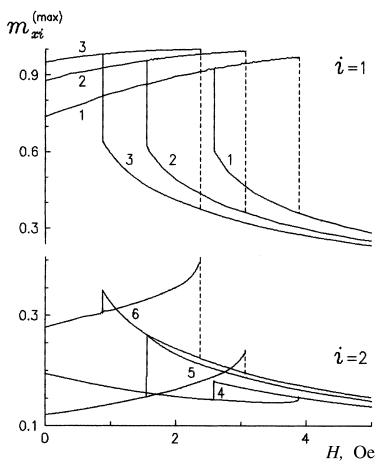


Рис. 2. Полевая зависимость высокочастотной намагниченности первой (кривые 1–3) и второй (кривые 4–6) пленок для различных значений константы связи A при $\omega=\omega_{01}$ и $h=1.5\,\mathrm{Oe}.$

На рис. 2 приведена зависимость амплитудных значений x-компонент магнитных моментов первой (кривые 1–3) и второй (кривые 4–6) пленок при установившемся прецессионном движении, т.е. величины

 $m_{vi}^{(\mathrm{max})}$, от величины подмагничивающего поля H на частоте $\omega=\omega_{01}$ при значениях константы связи $|A| = (1, 5, 9) \cdot 10^{-3}$ (кривые 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6) и амплитуде поля h = 1.5 Ое. Видно, что с увеличением подмагничивающего поля Н амплитуда колебания намагниченности в пленке, собственная частота которой равна частоте СВЧ-поля, вначале плавно растет, а затем резко падает и реализуется режим бистабильности. Это связано с проявляющейся асимметрией формы резонансных кривых относительно резонансной частоты ω_i , которая имеет место в случае достаточно больших амплитуд высокочастотного поля h. Зависимость от поля H амплитуды колебаний магнитного момента второй пленки иная: при малых значениях константы связи |A| величина $m_{\chi 2}^{({
m max})}$ незначительно снижается с ростом H, а при больших — вначале растет и, только пройдя область бистабильности, монотонно уменьшается. В области бистабильности наблюдается пересечение двух ветвей зависимости $m_{v2}^{(\mathrm{max})}(H)$, т.е. имеет место такая величина подмагничивающего поля H_c , при которой два стационарных динамических состояния системы отличаются амплитудой колебания намагниченности только первой пленки. Однако как при слишком малой, так и при слишком большой константе связи данная особенность в области режима бистабильности отсутствует.

Приведенный анализ показал, что в двухслойной магнитосвязанной системе с разделяющим немагнитным слоем, обеспечивающим ферромагнитный тип взаимодействия магнитных моментов слоев (A < 0), проявляются нелинейные эффекты, приводящие к смещению частоты прецессии при увеличении амплитуды СВЧ-поля и возникновению областей динамической бистабильности. Сильное различие (в несколько раз) амплитуд прецессии магнитных моментов практически во всей области динамической бистабильности, делают рассматриваемую систему очень чувствительной к изменениям параметров как высокочастотных, так и статических полей, что может быть использовано при создании на основе указанных систем различных СВЧ-устройств.

Список литературы

- [1] *Гуревич А.Г., Мелков Г.А.* Магнитные колебания и волны. М.: Наука, 1994. 464 с.
- [2] Neite B., Doetsch H. // J. Appl. Phys. 1987. V. 62(2). P. 648-652.
- [3] Резенда С.М., де Агиар Ф.М. // ТИИЭР. 1990. Т. 78. В. 6. С. 5–20.

- [4] Темирязев А.Г., Тихомирова М.П., Маряхин А.В. // Тез. докл. Междунар. школы-семинара HMMM-XVI. 23–26 июня 1998 г. М., 1998. Ч. 1. С. 270– 271.
- [5] Шутый А.М., Семенцов Д.И. // ЖЭТФ. 2000. Т. 118. В. 3(9). С. 110–116.
- [6] Gnatzig K., Doetsch H., Ye M. et al. // J. Appl. Phys. 1987. V. 62. N 12. P. 4839–4842.
- [7] Bordman A.D., Nikotov S.A., Wang Q. // IEEE Trans. 1994. V. MAG30. N 1. P. 1–4.
- [8] Prabhakar A., Stancil D.D. // J. Appl. Phys. 1999. V. 85. N 8. P. 4859–4863.
- [9] Фетисов Ю.К., Петтон К.Э. // РиЭ. 2000. Т. 45. № 6. С. 735–741.
- [10] Бебенин Н.Г., Устинов В.В. // ФММ. 1997. Т. 84. В. 2. С. 29–34.
- [11] *Дровосеков А.Б., Крейнес Н.М., Холин Д.И.* и др. // Тез. докл. Междунар. школы-семинара HMMM-XVI. 23–26 июня 1998 г. М., 1998. Ч. 1. С. 14–15.